

NXP, 업계 최대 포트폴리오의 듀얼 파워-SO8 MOSFET 제품군 선보여

패셔너블하고 독특한 스마트키 설계를 가능하게 하는 소형 패키지

NXP 반도체(NASDAQ: NXPI)는 오늘, 연료 분사, ABS, 안정화 제어와 같은 차량용 애플리케이션에 특화된 듀얼 파워-SO8 MOSFET 제품군인 LFPAK56D 포트폴리오 – 를 출시했다. AEC-Q101 인증을 완벽하게 획득한 NXP의 [LFPAK56D](#) 제품군은 동급 최강의 성능과 신뢰성을 제공한다. 이는 2개의 디바이스가 필요한 동급의 DPAK 솔루션에 비해 풋프린트를 77% 줄인 것이다. LFPAK56D 제품군은 현재 양산 중이며, 지금 바로 사용 가능하다.

LFPAK56D는 자동차 업계의 엄격한 요구사항을 충족하기 위해 2개의 개별 MOSFET을 하나의 패키지에 디자인했다. 5가지 전압 등급을 넘나드는 업계에서 가장 광범위한 온저항(RDSon) 범위로, 이 제품은 최고의 성능과 전류 핸들링, 시장의 신뢰성을 제공한다. 이 듀얼 파워-SO8 MOSFET의 새로운 제품은 고객들에게 애플리케이션과 모듈 요구 사항을 최적으로 조합하면서도 전력 밀도(power density)를 매우 높일 수 있는 디바이스를 선택할 수 있는, 완벽한 유연성과 자유를 제공한다.

LFPAK56D로 설계할 경우 보다 단순한 PCB 조립과 간편한 검토, 모듈 크기의 축소로 비용을 줄일 수 있다. 모듈이 작아진다는 것은 무게 또한 상당히 줄어든다는 것으로, CO2 배출을 줄이기 위해 노력하는 제조사들에게 매우 매력적이다.

NXP는 AEC-Q101 인증을 완벽하게 통과한 최초의 파워-SO8 패키지인 LFPAK56의 전문성을 바탕으로, 신뢰할 수 있는 "copper clip" 접착 기술을 LFPAK56D의 듀얼 파워-SO8 MOSFET에도 똑같이 적용했다. 이 copper clip 기술은 낮은 패키지 저항, 유도, 높은 최대 ID 율에 장점을 제공한다.

주요 특징

- 듀얼 파워-SO8 MOSFET
- 동급 DPAK 솔루션 대비 77% 작아진 풋프린트

- Copper clip 기술 – 유선 접착 불필요
- 높은 최대 ID 율
- 낮은 패키지 저항 및 유도
- 낮은 열 저항
- 높은 과도 전류 강인성
- 175°C 에 이르는 차량용 AEC-101 인증

관련 링크

NXP LFPADK56D 파워 MOSFET 포트폴리오: <http://www.nxp.com/LFPAK56D>

NXP MOSFET 전체 소개: <http://www.nxp.com/mosfets>